

第12回

徳島大学研究者との集い

半導体デバイス材料開発研究に挑む研究者達の素顔

日時：平成24年6月8日（金）14:00～17:30

会場：大阪大学中之島センター 3階

懇話会は同センター6階 徳島大学サテライトオフィス

主催：徳島大学 産学官連携推進部

協賛：徳島大学工業会

徳島大学工業会近畿支部連合会

徳島大学薬友会

第1部 講演会 14:00～

14:00～ 主催者挨拶（佐竹 弘：産学官連携推進部 副部長・教授）

14:05～ 講演者：永瀬 雅夫 教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門（工学部 電気電子工学科）

演 題：高品質エピタキシャルグラフェン作製

概要：ポストシリコン材料として期待されているグラフェンの各種応用技術に関する研究を行っている。SiC上エピタキシャルグラフェンの層数を精密に制御して試料全体に単層グラフェンを形成することに成功した。

14:45～ — 永瀬先生との名刺交換（休憩） —

14:55～ 講演者：西野 克志 准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門（工学部 電気電子工学科）

演 題：窒化物半導体のバルク結晶成長

概要：発光材料および高周波大電力デバイス用材料として窒化物半導体が注目されその研究は大きく進展しているものの、適当な結晶成長用基板が安価で入手できないという問題は残されたままである。本講演では、この問題の解決のため我々のグループで進めてきた窒化物半導体基板作製法について紹介する。

15:35～ — 西野先生との名刺交換（休憩） —

15:45～ 講演者：菽 金平 准教授

大学院ソシオテクノサイエンス研究部 先進物質材料部門（工学部 電気電子工学科）

演 題：窒化ガリウム電子デバイスの研究と開発

概要：窒化ガリウム(GaN)はワイドバンドギャップ半導体として青色発光ダイオードなどの光電子デバイスの他、高周波、高出力、低損失の電子デバイスへの応用も期待できる。本講演では、GaN系を用いたマイクロ整流用ショットキーダイオード、エンハンスメント型MOSFET、耐熱デバイス、液体センサなどの電子デバイスの研究と開発について紹介する。

16:25～ — 菽 先生との名刺交換（休憩） —

第2部 研究者との懇話会 16:35～17:30

●お問い合わせ先：徳島大学 産学官連携推進部

電話：088(656)7592 FAX：088(656)7593

E-mail：center@ccr.tokushima-u.ac.jp



第12回徳島大学研究者との集い 参加のお申し込み

必要事項をご記入の上、下記「問い合わせ先」までFAX又はE-mailにてお申し込み下さい。

申込締切：平成24年6月5日（火）

※インターネット上に申込フォームも用意しております。産学官連携推進部のホームページからご確認ください。

<http://www.ccr.tokushima-u.ac.jp/>

会社名			
住所	〒		
電話		FAX	

氏名	所属・役職	E-mail	懇話会	マッチング 相談会	参加の 有無
			参加 不参加	永瀬教授	有・無
			参加 不参加	西野准教授	有・無
			参加 不参加	敖准教授	有・無
			参加 不参加	※どちらかに○印をお付け下さい	



● 交通アクセス

- 京阪中之島線：中之島駅から徒歩約5分（中之島行きに乗車）
- JR環状線福島駅、JR東西線新福島駅、阪神電車本線福島駅、地下鉄四ツ橋線肥後橋駅から徒歩8～10分
- 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅から 徒歩16分
- JR大阪駅から徒歩20分

● 大阪大学中之島センター

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4-3-53
電話：06(6444)2100

● お問い合わせ先：徳島大学 産学官連携推進部 電話：088(656)7592
FAX：088(656)7593 E-mail：center@ccr.tokushima-u.ac.jp
URL：http://www.ccr.tokushima-u.ac.jp/topic/topic-tsudoi.html